



# Joint 114年 Developed 高階人才養成計畫 Project



## 徵求公告稿

一、本計畫之推動，係國家實驗研究院台灣半導體研究中心(以下簡稱TSRI)為協助國內教授群共同從事前瞻奈米元件技術開發，以期加值學界優秀的研究成果，並藉此培育碩博士級中高階研究人才，維持台灣在高科技產業的競爭優勢。

二、計畫自即日起接受申請，請於113年11月30日(星期六)前以電子郵件方式寄送計畫構想書予本案聯絡窗口，逾期不予受理。

聯絡窗口：謝小姐 03-5773693 # 7724。

Email: plhsieh@narlabs.org.tw

三、申請與構想書撰寫注意事項：

(一)申請資格：國內各公私立大專院校教授研究群；於國內外擔任教學、研究專任職務在五年以內或獲博士學位後五年以內之專任教學、研究人員，得以隨到隨審的方式申請本計畫。

(二)計畫執行期限：計畫採一年一審，執行期限為一年

(三)支援項目：折抵半導體中心儀器設備使用費、至多2名免費上課的學生，課程限半導體製程技術訓練班(SM01)及半導體製程設備見習班(SM01-1)

(四)申請資料：計畫構想書(A4直式橫書撰寫、14級字、內容至多2頁)

(五)核定儀器設備使用費折抵依據：

(1)計畫構想書內容：半導體中心儀器設備可支援性(佔比20%)

(2)團隊近三年於半導體中心績效系統填報情形：完成的碩博士畢業論文人數(佔比40%)、發表論文數與獲得專利件數(佔比40%)

(六)鼓勵措施：

配合晶創計畫布局台灣半導體基礎設施與人才培育措施，本案鼓勵更多研究團隊投入半導體領域，近三年於半導體中心無製程技術服務紀錄或首次申請團隊，當年度核給使用額度100萬元。

四、參與計畫義務

(一)至本中心指定的填報系統線上填寫論文發表、人才培育、專利技轉、其它獲獎等研究成果。

(二)發表論文須致謝台灣半導體研究中心。

(三)如屬雙方合作產出之智慧財產(專利、技術移轉)，應依國家科學及技術委員會、財團法人國家實驗研究院相關規定辦理。